

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 4 区分

【発行日】平成30年10月18日 (2018.10.18)

【公開番号】特開2017-59281(P2017-59281A)

【公開日】平成29年3月23日 (2017.3.23)

【年通号数】公開・登録公報2017-012

【出願番号】特願2015-181628(P2015-181628)

【国際特許分類】

G 1 1 C 16/02 (2006.01)

G 0 6 F 3/08 (2006.01)

G 1 1 C 16/04 (2006.01)

【 F I 】

G 1 1 C 17/00 6 1 2 F

G 0 6 F 3/08 H

G 1 1 C 17/00 6 2 2 E

G 1 1 C 17/00 6 4 1

【手続補正書】

【提出日】平成30年9月10日 (2018.9.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 3 2 】

図 1 0 のようなセル電位とステートとの関係を考慮して、一部のページ 4 のみを消去する場合に、コントローラ 1 3 は、消去対象の一部のページ 4 において、各メモリセル 2 3 にステートの変化が 1 段階しか起きないような所定のデータを作成または選択して上書きする。特に、ステートの変化が下位から上位へと 1 段階しか起きないような所定のデータを作成または選択して上書きする。上述の M L C の例とは異なり、消去するページの順番や書かれているデータに関係なく、消去対象の一部のページ 4 として、ページ A またはページ B を消去する場合には、ページ A またはページ B 内のすべてのメモリセル 2 3 に対して、所定のデータとして、“ 1 ” のデータを上書きする。また、消去対象の一部のページ 4 として、ページ C を消去する場合には、ページ C 内のすべてのメモリセル 2 3 に対して、所定のデータとして、“ 0 ” のデータを上書きする。それぞれの場合において、書き込みによりメモリセル 2 3 のステートは図 1 1 ~ 図 1 3 のように変化する。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 1 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 13】

上書き前 データ	スタート	消去	A	B	C	D	E	F	G
	ページ A	1	1	1	0	0	0	0	1
	ページ B	1	1	0	0	1	1	0	0
	ページ C	1	0	0	0	0	1	1	1
ページ C 上書きデータ (ALLQ)									
ページ C 上書き後 データ	スタート	A	A	B	C	D	E	F	G
	ページ A	1	1	1	0	0	0	0	1
	ページ B	1	1	0	0	1	1	0	0
	ページ C	0	0	0	0	0	1	1	1